

Содержание

● XXIX Симпозиум „Нанофизика и наноэлектроника“, Н. Новгород, 10–14 марта 2025 г.

Смагина Ж.В., Зиновьев В.А., Мудрый А.В., Бородавченко О.М., Баженов А.О., Двуреченский А.В., Живулько В.Д.

Фотолюминесценция гетероструктур Ge/Si с квантовыми точками, созданными в процессе эпитаксии из ионно-молекулярных пучков 55

Резник А.Н., Востоков Н.В.

Малосигнальная электрическая схема диода Шоттки по данным микроволновой спектроскопии 60

Литвяк В.М., Кузнецова М.С., Бердников В.С., Бажин П.С., Кавокин К.В.

Измерение ядерного локального поля методом адиабатического размагничивания в квантовой яме CdTe/CdZnTe . . . 73

Афоненко Ан.А., Афоненко А.А., Ушаков Д.В., Хабибуллин Р.А.

Неоднородное уширение энергетических уровней при флуктуации концентрации легирования в квантово-каскадных лазерах 79

Селиверстов С.В., Кожуховский А.К., Фудин Д.Г., Святодух С.С., Лазаренко П.И., Терехов Д.Ю., Проходцов А.И., Невзоров А.А., Светухин В.В., Ковалюк В.В., Гольцман Г.Н.

Интегральный субтерагерцовый волноводный реконфигурируемый аттенюатор на основе материала $Ge_2Sb_2Te_5$ с фазовой памятью 84

Чумаков Н.К., Андреев А.А., Белов И.В., Гончаров Б.В., Грищенко Ю.В., Езубченко И.С., Давыдов А.Б., Занавескин М.Л., Колобкова Е.М., Моргун Л.А., Николаев С.Н., Приходько К.Е., Черных И.А., Шабанов С.Ю., В.Г.Валеев

Магнетопольная характеристика физических свойств двумерного электронного газа нитридных транзисторных гетероструктур с высокой подвижностью электронов 91

Чмырь С.Н., Галеева А.В., Долженко Д.Е., Никорич А.В., Хохлов Д.Р.

Микроволновая фотопроводимость в полуизолирующих твердых растворах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ 97

Дураков Д.Е., Петров А.С., Роголо Д.И., Макаева А.А., Насимов Д.А., Никифоров Д.Ф., Курьусь Н.Н., Милехин А.Г., Щеглов Д.В., Латышев А.В.

Контроль формирования слоев графена на подложках 6H-SiC(0001) методом *in situ* дифракции быстрых электронов на отражение 102

Курмачев Д.А., Квон З.Д., Михайлов Н.Н.

Двумерный топологический андерсоновский изолятор в режиме квазибаллистического транспорта 109

● Физика полупроводниковых приборов

Орешко И.В., Золотарев В.В., Слипченко С.О., Казакова А.Е., Пихтин Н.А.

Резонаторы ИК лазеров на основе двумерных фотонных кристаллов для организации поверхностного вывода излучения 113